課題番号 : F-18-OS-0024

利用形態:機器利用

利用課題名(日本語) :機能性酸化物を用いたナノ構造体作製と評価

Program Title (English) : Fabrication of functional oxide nano-structures

利用者名(日本語) :神吉輝夫、服部梓、山本真人、Alexis Borowiak、Rupali Rakshit、頓田佐映子、

榊奈津子、近成将司、辻佳秀、川本大喜、安西勇人、村岡敬太、遠藤史也、谷村 俊樹、

玄地真悟、山中天志、鈴木寿弥、野中信

Username (English) : T. Kanki, A. Hattori, M. Yamamoto, A. Borowiak, R. Rakshit, S. Tonda, K. Sakai,

M. Chikanari, Y. Tsuji, T. Kawamoto, Y. Anzai, K. Muraoka, F. Endo, T. Tanimura,

S. Genti, T. Yamanaka, T. Suzuki, S. Nonaka

所属名(日本語) :大阪大学 產業科学研究所 Affiliation (English) :ISIR, Osaka University

1. 概要(Summary)

機能性酸化物薄膜のナノスケール化は、電子相転移 制御や量子効果等のナノ物性の興味に加え、低電力駆動、高集積化に直結する重要な課題である。そこで、 我々は、酸化物トップダウン・ボトムアップナノテク ノロジーを融合した技術的方法論を確立し、酸化物ナ ノ構造の作製、及び新奇ナノエレクトロニクスの開拓 を行っている。

2. 実験 (Experimental)

【利用した主な装置】ナノインプリント装置、リアクティブイオンエッチング装置、超高精細電子ビームリソグラフィー装置、RFスパッタ成膜装置

【実験方法】

上記装置群を用いて酸化物薄膜の微細加工を行った。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

二酸化バナジウム (VO2) は 300K 付近で、構造相 転移を伴った金属-絶縁体転移 (MIT) を起こし、3桁 以上もの抵抗変化を示す材料としてよく知られてい る。VO2薄膜では、MIT温度付近において、金属相と 絶縁体相の2つの異なる電子相が数十 nm の大きさで 混在していることがこれまでに報告されており、ドメ インの数、配置、配列は電気物性の特性を大きく変化 させる。本報告ではVO2の単一電子相の電気特性を調 べるために 20 nm の電極ギャップを持つ単結晶 VO2 ナノワイヤー薄膜を作製し、これまでの薄膜では見ら れない急峻な単一抵抗跳躍の観測に成功した。パルス レーザデポジション法により TiO2(001)基板上に単結 晶 VO2薄膜を作製し、ナノインプリントリソグラフィ 一法を用いて、ナノワイヤー構造に加工した。また電 子線描画装置 125KV-EB を用いてでパターニングを 行い、電極を作製した。Figure 1(a),(b)は作製したデ バイスの SEM 像で、VO₂幅 100 nm、電極間距離 2 μm、 及び 20 nm の領域を示す。Figure 1(c)では多数のド

メイン構造によるマルチステップ MIT が観測された 一方で、は VO_2 薄膜、電極間距離が $20~\rm nm$ における 温度に対する抵抗変化は、 $1~\rm Q$ 階の巨大な抵抗変化の 観測に成功した(Figure 1(d))。

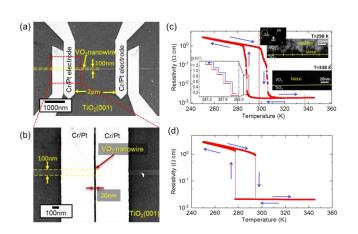


Figure 1 Scanning electron microscopy images of 100-nm-wide VO_2 wires with (a) 2- μ m and (b) 20-nm electrode gaps and temperature dependence of resistivity in the VO_2 nanowires with (c) 2- μ m and (d) 20-nm electrode gaps.

<u>4. その他・特記事項(Others)</u> 関連課題番号: S-18-OS-0020

5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)

 Y. Tsuji, T. Kanki, Y. Murakami and H. Tanaka, Applied Physics Express Vol. 12 (2019) 025003.
M. Chikanari, T. Kanki, T. Wei and H. Tanaka, Applied Physics Letters Vol.113 (2018) 053102.

6. 関連特許 (Patent)

なし。